2SB1315/2SD1977

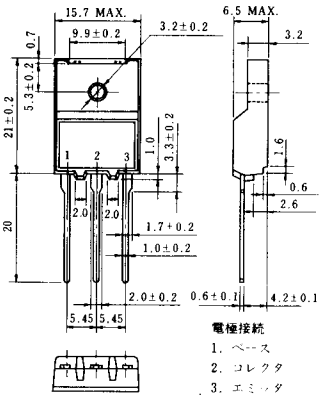
PNPエピタキシアル/NPN三重拡散形シリコントランジスタ
低周波電力増幅用

PNP Epitaxial/NPN Silicon Triple Diffused
Transistor Audio Frequency Power Amplifier

特　徴

○実効出力45～55 W (Single PP, R_L=8 Ω)のパワーアンプ出力用。
○NewEBT構造を採用，f_Tが高く，破壊強度が優れています。
○直流電流増幅率h_{FE}の電流特性が優れています。
○絶縁板および絶縁ブッシングが不要なモールドパッケージです。

外形図（単位：mm）



絶対最大定格（T_a=25 ℃）

項　目	略　号	2SB1315	2SD1977	単位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	−120	120	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	−120	120	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	−5.0	5.0	V
コレクタ電流	$I_{C(DC)}$	−8.0	8.0	A
コレクタ電流	$I_{C(pulse)}$ *	−12	12	A
全損失	$P_{T(T_C=25\,℃)}$	65		W
全損失	$P_{T(T_a=25\,℃)}$	3.5		W
ジャンクション温度	T_j	150		℃
保存温度	T_{stg}	−55～+150		℃

*PW≦10 ms, Duty Cycle≦50 %

電気的特性（T_a=25 ℃）

2SB1315/2SD1977

項　目	略　号	条　件	MIN.	TYP.	MAX.	単　位
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	V_{CB}=−120/120 V, I_E=0			−50/50	μA
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	V_{EB}=−5.0/5.0 V, I_C=0			−50/50	μA
直流電流増幅率	h_{FE1} **	V_{CE}=−5.0/5.0 V, I_C=−50/50 mA	40	150/120		
直流電流増幅率	h_{FE2} **	V_{CE}=−5.0/5.0 V, I_C=−1.0/1.0 A	60	140	320	
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$ **	I_C=−5.0/5.0 A, I_B=−0.5/0.5 A		−0.65/0.65	−1.5/1.5	V
ベース飽和電圧	$V_{BE(sat)}$ **	I_C=−5.0/5.0 A, I_B=−0.5/0.5 A		−1.25/1.25	−2.0/2.0	V
コレクタ容量	C_{ob}	V_{CB}=−10/10 V, I_E=0, f=1.0 MHz		200/120		pF
利得帯域幅積	f_T	V_{CE}=−5.0/5.0 V, I_C=−1.0/1.0 A		65/60		MHz

**パルス測定　PW≦350 μs, Duty Cycle≦2 %

h_{FE}規格区分

捺印	M	L	K
h_{FE2}	60～120	100～200	160～320

ご要求は2ランク以上の範囲でお願いします。